



RoHS対応品

■特長

- 小型セラミックパッケージタイプ
- シームによる高信頼性
- CMOS出力
- 電源電圧 V_{cc}=3.3V
- 低ジッター

■周波数許容偏差(Overall)

許容偏差 コード×10 ⁻⁶	動作温度範囲 (°C)	備考
0 ±50	-10 ~ +70	標準仕様
S ±30	-10 ~ +70	対応可能周波数についてはお問い合わせください
G ±50	-40 ~ +85	

■品名表示方法

KV5032D 74.1758 C 3 0 D 00
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①型名(5.0×3.2mm SMD VCXO)
- ②出力周波数
- ③出力形態(CMOS)
- ④電源電圧(3.3V)
- ⑤周波数許容偏差(左記表を参照ください)
- ⑥シンメトリ/ INH機能/ 制御入力抵抗の組合せ
- ⑦客先個別仕様(カタログ仕様は「00」になります)

包装形態(テーピング 1000個/ リール)

■規格

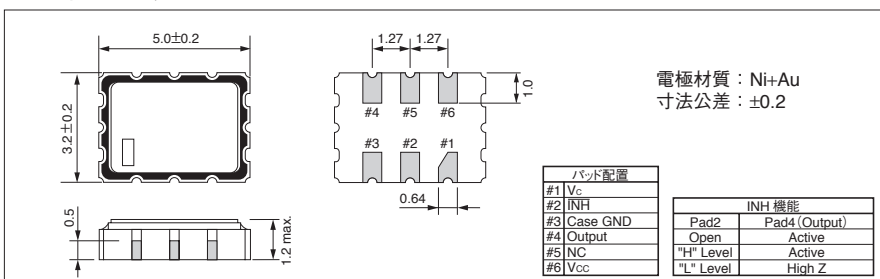
項目	記号	条件	Min.	Max.	単位
出力周波数範囲*	f _o		1.5	170	MHz
周波数許容偏差**	f _{tol}	初期偏差、動作温度範囲内での温度特性、電源電圧変動、負荷容量変動、経年変化(1 year @25°C)、振動・衝撃を含む Op. Temp.: -10 ~ +70°C/ -40 ~ +85°C Op. Temp.: -10 ~ +70°C	-50 -30	+50 +30	×10 ⁻⁶
絶対周波数可変範囲(APR)	APR	1.5 ≤ f _o ≤ 30MHz 30 < f _o ≤ 170MHz	±100 ±50	—	×10 ⁻⁶
制御電圧	V _c		0	+3.3	V
保存温度範囲	T _{stg}		-55	+125	°C
動作温度範囲	T _{use}	標準仕様 オプション	-10 -40	+70 +85	°C
最大定格電圧	—	1.5 ≤ f _o ≤ 80MHz 80 < f _o ≤ 170MHz	-0.5 -0.5	+7 +5	V
電源電圧	V _{cc}		+2.97	+3.63	V
消費電流	I _{cc}	1.5 ≤ f _o ≤ 80MHz 80 < f _o ≤ 170MHz	— —	15 35	mA
ディセーブル時電流	I _{dis}	1.5 ≤ f _o ≤ 80MHz 80 < f _o ≤ 170MHz	— —	10 50	mA μA
波形シンメトリ	SYM	50ohm @50% V _{cc}	45	55	%
立上り/ 立下り時間 (10% V _{cc} ~ 90% V _{cc})	tr/ tf	1.5 ≤ f _o ≤ 30MHz 30 < f _o ≤ 80MHz 80 < f _o ≤ 170MHz	— — —	8 5 4	ns
Lレベル出力電圧	V _{OL}		—	10% V _{cc}	V
Hレベル出力電圧	V _{OH}		90% V _{cc}	—	V
出力負荷条件(CMOS)	L_CMOS		—	15	pF
入力電圧範囲	V _{IN}		0	+3.3	V
Lレベル入力電圧	V _{IL}		—	30% V _{cc}	V
Hレベル入力電圧	V _{IH}		70% V _{cc}	—	V
制御入力抵抗	—	制御入力抵抗値コード⑥: D 制御入力抵抗値コード⑥: G or N	100 5	—	k ohm Mohm
ディセーブル時間	t _{dis}		—	100	ns
イネーブル時間	t _{ena}	1.5 ≤ f _o ≤ 80MHz 80 < f _o ≤ 170MHz	— —	100 2	ns ms
発振開始時間	t _{str}	最小動作電圧を0 sec.とする	—	10	ms
Phase Jitter	J _{Phase}	12kHz ~ 20MHz @155.52MHz	—	1	ps
位相ノイズ @155.52MHz	—	-55 (@10Hz offset) -85 (@100Hz offset) -115 (@1kHz offset) -130 (@10kHz offset) -145 (@100kHz offset) -150 (@1MHz offset) -155 (@10MHz offset)			dBc/ Hz

全ての電気的特性は最大負荷時、動作温度範囲内とします。

* レンジ外の周波数については、お問い合わせください。 ** -40 ~ +85°C仕様に関しては、お問い合わせください。

■形状・寸法

(単位: mm)



■推奨ランドパターン

(単位: mm)

